



Title of Change:	Qualification of Silan (Hangzhou, China) as an additional Wafer FAB for IPM LVIC BCH4B technology products	
Proposed first ship date:	19 June 2019	
Contact information:	Contact your local ON Semiconductor Sales Office or < Daniel.Jeon@onsemi.com >	
Samples:	Contact your local ON Semiconductor Sales Office or < PCN.samples@onsemi.com > Sample requests are to be submitted no later than 30 days from the date of first notification, Initial PCN or Final PCN, for this change.	
Additional Reliability Data:	Contact your local ON Semiconductor Sales Office or < Byeongyeop.Lee@onsemi.com >	
Type of notification:	This is a Final Product/Process Change Notification (FPCN) sent to customers. FPCNs are issued 90 days prior to implementation of the change. ON Semiconductor will consider this change accepted, unless an inquiry is made in writing within 30 days of delivery of this notice. To do so, contact < PCN.Support@onsemi.com > or < Daniel.Jeon@onsemi.com >.	
Change Part Identification:	The label listed on the box and reel will contain the CS (Custom Source) or "Diffused In" for the wafer FAB location. CS or Diffused In = CN will be from Silan, China, CS or Diffused In = KR will be from Bucheon, Korea. Material from (2) different wafer FABs cannot be combined onto (1) reel per internal specifications. Please see sample label on Page 2 at the following URL http://www.onsemi.com/pub/Collateral/LABELRM-D.PDF to see the location of the Custom Source/Diffused in Reference.	
Change Category:	<input checked="" type="checkbox"/> Wafer Fab Change <input type="checkbox"/> Assembly Change <input type="checkbox"/> Test Change <input type="checkbox"/> Other _____	
Change Sub-Category(s):	<input checked="" type="checkbox"/> Manufacturing Site Addition <input type="checkbox"/> Material Change <input type="checkbox"/> Datasheet/Product Doc change <input type="checkbox"/> Manufacturing Site Transfer <input type="checkbox"/> Product specific change <input type="checkbox"/> Shipping/Packaging/Marking <input type="checkbox"/> Manufacturing Process Change <input type="checkbox"/> Other: _____	
Sites Affected:	ON Semiconductor Sites: None	External Foundry/Subcon Sites: Hangzhou Silan Integrated Circuit Co, Ltd



Description and Purpose:

ON Semiconductor would like to inform our customers about our intent to qualify our IPM LVIC BCH4B technology products at the Silan (Hangzhou Silan Integrated Circuit Co, Ltd) FAB in Hangzhou, China. This qualification will enable expanded capacity for this technology.

Once qualification is complete and at the expiration of the FPCN, all products listed here will be dual sourced from its current ON Semiconductor wafer fab in Bucheon, Korea or Silan, China. FPCN's will be submitted in phases as different products are qualified.

	Before Change Description	After Change Description
FAB Location	Bucheon, Korea	Silan, China or Bucheon, Korea

Wafers produced in Silan are 5" while wafers produced in Bucheon are 6". This is a continuation to previous qualifications already performed transferring other Bipolar products from Bucheon to Silan.

Please note the appropriate contact person shown above for these products.

There are no product material changes as a result of this change

There is no product marking change as a result of this change

Reliability Data Summary:

QV Device Name FSBB30CH60C-F166

RMS #49919

Package SPM27

Test	Specification	Condition	Interval	Results
HTRB	JESD22-A108	Tj150°C, Vcc=15V, Vpn=150V (Low side)	1,008 hrs	0/36
HTSL	JESD22-A103	Ta 150°C	1,008 hrs	0/36
TC	JESD22-A104	Ta -40°C to +125°C	1,000 cyc	0/237
HAST	JESD22-A110	Ta 130°C, RH=85%, Vcc=15V, Vpn=42V	96 hrs	0/36
UHAST	JESD22-A118	Ta 130°C, RH=85%	96 hrs	0/35

QV Device Name FPAB30BH60B

RMS #53614

Package SPM45

Test	Specification	Condition	Interval	Results
TC	JESD22-A104	Ta -40°C to +125°C	1,000 cyc	0/12

Electrical Characteristic Summary:

Electrical characteristics are not impacted.

**List of Affected Parts:**

Note: Only the standard (off the shelf) part numbers are listed in the parts list. Any custom parts affected by this PCN are shown in the customer specific PCN addendum in the PCN email notification, or on the [PCN Customized Portal](#).

Part Number	Qualification Vehicle
FCBB20CH60SF	FSBB30CH60C-F166
FCBS0550	FSBB30CH60C-F166
FPAB20BH60B	FPAB30BH60B
FPAB30BH60B	FPAB30BH60B
FPDB40PH60B	FPAB30BH60B
FPDB60PH60B	FPAB30BH60B
FSAM50SM60A	FPAB30BH60B
FSAM75SM60A	FPAB30BH60B
FSAM75SM60SL	FPAB30BH60B
FSB7401MX	FSBB30CH60C-F166
FSBB15CH60C	FSBB30CH60C-F166
FSBB20CH60C	FSBB30CH60C-F166
FSBB20CH60CT	FSBB30CH60C-F166
FSBB20CH60CTSL	FSBB30CH60C-F166
FSBB30CH60C	FSBB30CH60C-F166
FSBB30CH60C-F166	FSBB30CH60C-F166
FSBB30CH60CT	FSBB30CH60C-F166

Japanese translation of the notification starts here.
通知の日本語訳はここから始まります。

Note: The Japanese version is for reference only. In case of any differences between the English and Japanese version, the English version shall control.

注：日本語版は参照用です。英語版と日本語版の違いがある場合は、英語版が優先されます。



最終製品 / プロセス変更通知

文書番号# : FPCN22561X

発行日: 12 March 2019

変更件名:	IPM LVIC BCH4B テクノロジー製品の追加ウエハ FABとして Silan(中国、杭州)の認定	
初回出荷予定日:	19 June 2019	
連絡先情報:	現地のオン・セミコンダクター営業所または <Daniel.Jeon@onsemi.com> お問い合わせください。	
サンプル:	現地のオン・セミコンダクター営業所または <PCN.Samples@onsemi.com> お問い合わせください。 サンプルは、この変更の初回通知、初回 PCN の日付から 30 日以内に要求してください。	
追加の信頼性データ:	お客さまの地域のオン・セミコンダクター営業所または <Byeongyeop.Lee@onsemi.com> お問い合わせください。	
通知種別:	これは、お客様宛の最終製品 / プロセス変更通知 (FPCN) です。FPCN は、変更実施の 90 日前に発行されます。オン・セミコンダクターは、この通知の送付から 30 日以内に書面による問い合わせがない限り、この変更が承諾されたものとみなします。お問い合わせは、<PCN.Support@onsemi.com> 宛てにお願いします。	
変更部品の識別:	ボックスおよびリール上にリストされたラベルにはウエハ FAB 拠点を示す CS (カスタマーソース) または DIFFUSED IN コードが記載されています。Silan (中国) 品の CS/DIFFUSED IN コードは CN、ON Bucheon (韓国) 品の CS/DIFFUSED IN コードは KR と表示されます。社内規定により両ウエハ Fab 拠点の製品を 1 つのリールに混在させることはありません。 CS/DIFFUSED IN コードの位置については 以下の URL にある冊子の 2 ページ目のサンプルラベルをご参照ください。 http://www.onsemi.com/pub/Collateral/LABELRM-D.PDF	
変更カテゴリ:	<input checked="" type="checkbox"/> ウエハファブの変更 <input type="checkbox"/> アセンブリの変更 <input type="checkbox"/> 試験の変更 <input type="checkbox"/> その他 _____	
変更サブカテゴリ:	<input checked="" type="checkbox"/> 製造拠点の追加 <input type="checkbox"/> 材料の変更 <input type="checkbox"/> データシート/製品資料の変更 <input type="checkbox"/> 製造拠点の移転 <input type="checkbox"/> 製品仕様の変更 <input type="checkbox"/> 出荷/パッケージング/表記 <input type="checkbox"/> 製造プロセスの変更 <input type="checkbox"/> その他: _____	
影響を受ける拠点:	オン・セミコンダクター拠点: なし	外部製造工場 / 下請業者拠点: Hangzhou Silan Integrated Circuit Co, Ltd



最終製品 / プロセス変更通知

文書番号# : FPCN22561X

発行日: 12 March 2019

説明および目的:

オン・セミコンダクターは中国の杭州市にある Silan (Hangzhou Silan Integrated Circuit Co, Ltd) FAB において IPM LVIC BCH4B テクノロジー製品を認定する意向であることをお知らせします。本認定により本テクノロジーの生産能力を拡大できるようになります。

認定が完了し最終通知 FPCN が実行された後は、全ての対象製品は既存のウェハー製造拠点である ON Bucheon (韓国) と Silan (中国) とのデュアルソース品となります。別製品の認定が完了した段階で最終通知 FPCN は発行されます。

	変更前の表記	変更後の表記
FAB の場所	ON Bucheon (韓国)	Silan (中国) または ON Bucheon (韓国)

ON Bucheon FAB のウェハーサイズは 6 インチですが、Silan FAB のウェハーサイズは 5 インチとなります。また、本件は他のバイポーラ製品で既に実施された Bucheon から Silan への移管認定に続くものです。

これらの製品についての、適切な担当者は上記となります。

今回の変更に伴う製品材料の変更はありません。

今回の変更に伴う製品マーキングの変更はありません。

信頼性データの要約:

デバイス名: FSBB30CH60C-F166

RMS #49919

パッケージ: SPM27

テスト	仕様	条件	間隔	結果
HTRB	JESD22-A108	Tj150°C, Vcc=15V, Vpn=150V (Low side)	1,008 hrs	0/36
HTSL	JESD22-A103	Ta 150°C	1,008 hrs	0/36
TC	JESD22-A104	Ta -40°C to +125°C	1,000 cyc	0/237
HAST	JESD22-A110	Ta 130°C, RH=85%, Vcc=15V, Vpn=42V	96 hrs	0/36
UHAST	JESD22-A118	Ta 130°C, RH=85%	96 hrs	0/35

デバイス名: FPAB30BH60B

RMS #53614

パッケージ: SPM45

テスト	仕様	条件	間隔	結果
TC	JESD22-A104	Ta -40°C to +125°C	1,000 cyc	0/12

電気的特性の要約:

電気的特性への影響はありません。



影響を受ける部品の一覧:

注: 部品一覧には標準部品番号 (既製品) のみが記載されています。本 PCN の影響を受けるカスタム部品番号は、PCN メールで提供される顧客個別の付録、または PCN カスタマイズポータルに記載されています。

部品番号	認定試験用ピークル
FCBB20CH60SF	FSBB30CH60C-F166
FCBS0550	FSBB30CH60C-F166
FPAB20BH60B	FPAB30BH60B
FPAB30BH60B	FPAB30BH60B
FPDB40PH60B	FPAB30BH60B
FPDB60PH60B	FPAB30BH60B
FSAM50SM60A	FPAB30BH60B
FSAM75SM60A	FPAB30BH60B
FSAM75SM60SL	FPAB30BH60B
FSB7401MX	FSBB30CH60C-F166
FSBB15CH60C	FSBB30CH60C-F166
FSBB20CH60C	FSBB30CH60C-F166
FSBB20CH60CT	FSBB30CH60C-F166
FSBB20CH60CTSL	FSBB30CH60C-F166
FSBB30CH60C	FSBB30CH60C-F166
FSBB30CH60C-F166	FSBB30CH60C-F166
FSBB30CH60CT	FSBB30CH60C-F166